Panasonic ICP I	RECIPE 118: SiO2 vert							
	Vertical SiO2 etch							
			STEP1	STEP2	STEP3	STEP4	STEP5	STEP6
Gas flow	limit	unit						
A: BCl3	20%	sccm	0	0	0	0	0	0
B:Cl2	20%	sccm	0	0	0	0	0	0
C: CF4	20%	sccm	0	0	0	0	0	0
D:O2	20%	sccm	0	0	0	0	0	0
E:CHF3	20%	sccm	40	40	40	0	0	0
F:N2	20%	sccm	0	0	0	100	100	0
Pre.	20%	Pa	2	0.5	0.5	2.5	2.5	0
Vacing time		M:S	0:00	0:00	0:15	0:00	0:15	0:00
RF wait time		M:S	0:15	0:00	0:00	0:15	0:00	0:00
SRC fwd	20%	W	900	900	900	100	50	0
SRC Ref	20W							
BIAS fwd	20%	W	0	0	200	0	0	0
BIAS ref	20W							
Dead time			0:30	0:05	0:05	0:10	0:05	0:00
EPM		M:S	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
Step time		M:S	0:02	0:02	enter time	0:10	0:05	0:00
Over etch		%	0	0	0	0	0	0
Over etch		M:S	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
end detected								